

	<p>SIR610DP-T1-RE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR610DP-T1-RE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 35.4A SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR610DP-T1-RE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR610DP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 35.4A SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	31.9 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR610DP-T1-RE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1380pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 35.4A (Tc) 104W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35.4A (Tc)

SIR610DP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR610DP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR610DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR610DP-T1-RE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR618DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 14.2A SO8</p>	 <p>SIR616DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 20.2A SO8</p>	 <p>SIR622DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 51.6A SO8</p>	 <p>SIR618DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 14.2A SO-8</p>
 <p>SIR496DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR606BDP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIR616DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 20.2A SO-8</p>	 <p>SIR606DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 37A POWERPAKSO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR610DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR610DP-T1-RE3 Datenblatt	SIR610DP-T1-RE3-Datenblätter	SIR610DP-T1-RE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR610DP-T1-RE3
SIR610DP-T1-RE3 Electronic	SIR610DP-T1-RE3-Komponenten	SIR610DP-T1-RE3-Verteiler	SIR610DP-T1-RE3-Bild	SIR610DP-T1-RE3-Teil
SIR610DP-T1-RE3 Preis	SIR610DP-T1-RE3 Hersteller	SIR610DP-T1-RE3 Bild	SIR610DP-T1-RE3 Aktie	SIR610DP-T1-RE3 Inventar
SIR610DP-T1-RE3 Neu	SIR610DP-T1-RE3 Original	SIR610DP-T1-RE3 garantiert	SIR610DP-T1-RE3 RFQ	SIR610DP-T1-RE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited